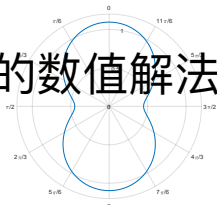
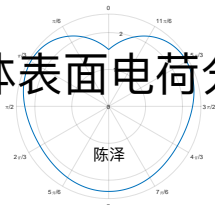
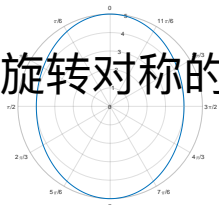


旋转对称的导体表面电荷分布的数值解法



* 花生好像不是导体



旋转对称导体的电势的形式

导体外部的电势 V 是 Laplace 方程

$$\nabla^2 V = 0$$

的解, 在具有旋转对称性的情形下, V 具有形式

$$V = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A_k P_k(\cos \theta)}{r^{k+1}}.$$

当级数收敛时, 取前 $n + 1$ 项截断得到的

$$V_n = \sum_{k=0}^n \frac{A_k P_k(\cos \theta)}{r^{k+1}}$$

可以作为足够好的近似.

■ 使 V 在导体表面为常量...解不出来的

$$\Rightarrow \text{退而求其次, 先考虑 } V_n = \sum_{k=0}^n \frac{A_k P_k(\cos \theta)}{r^{k+1}}.$$

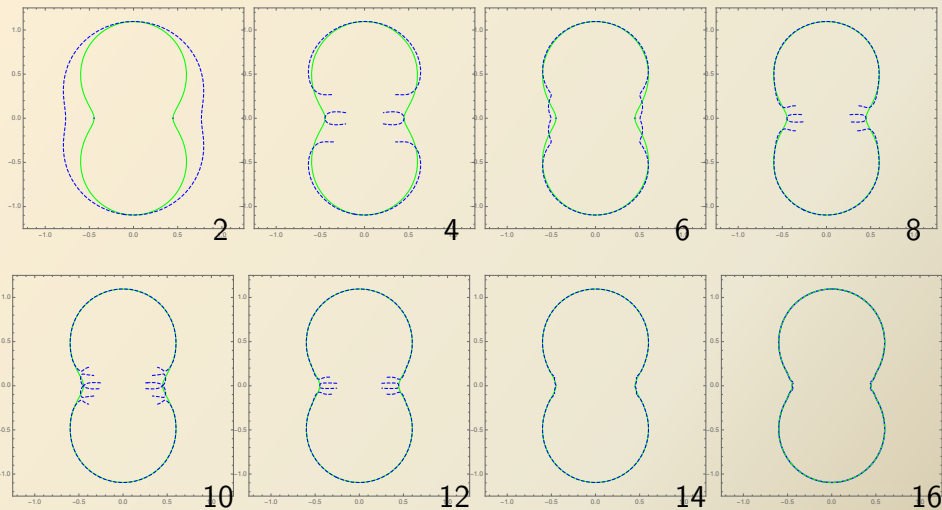
■ 但 V_n 在导体表面几乎是不可能为常量的...

\Rightarrow 再退而求其次, 让 V_n 在导体表面的 $n+1$ 个点处为常量.

■ 这其实就是解线性方程组: $n+1$ 个方程, $n+1$ 个系数.

\Rightarrow 小学生也会.

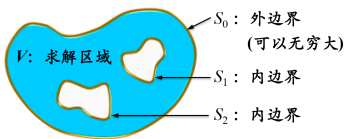
$$\begin{pmatrix} \frac{P_0(x_0)}{r(x_0)} & \frac{P_1(x_0)}{r(x_0)^2} & \cdots & \frac{P_n(x_0)}{r(x_0)^{n+1}} \\ \frac{P_0(x_1)}{r(x_1)} & \frac{P_1(x_1)}{r(x_1)^2} & \cdots & \frac{P_n(x_1)}{r(x_1)^{n+1}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{P_0(x_n)}{r(x_n)} & \frac{P_1(x_n)}{r(x_n)^2} & \cdots & \frac{P_n(x_n)}{r(x_n)^{n+1}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_0 \\ A_1 \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi_0 \\ \varphi_0 \\ \vdots \\ \varphi_0 \end{pmatrix}, \quad (1)$$



为什么这样能工作算对

- 为什么在 V 在导体表面为常数就可以得到正确的导体外的电势？

唯一性定理 I



The diagram shows a blue irregular region V with a hole. The outer boundary is labeled S_0 (外边界, 可以无穷大). The inner boundary of the hole is labeled S_1 (内边界). Another inner boundary is labeled S_2 (内边界). The region V is labeled as the solution region (求解区域).

在给定以 $S = \partial V$ 为边界的区域 V 内部的电荷分布前提下

- (1) 只需再给定边界 ∂S 上每一点的电势，
则 V 内电势(从而电场)唯一确定。
- (2) 若边界均为导体表面，只需再给定每一个内边界上的电量，
则 V 内电场唯一确定，而电势可相差一个任意常数。

2019年3月21日 电磁学A, 2018年春 1

■ 知道了 V , 要怎么知道 σ ?

$$\sigma = \frac{E}{\epsilon_0} = \left| \frac{\nabla V}{\epsilon_0} \right|.$$

但是你不知道 V , 你只知道 V_n .

■ 这种方法能保证 V_n 如果逐点收敛于 V 吗?

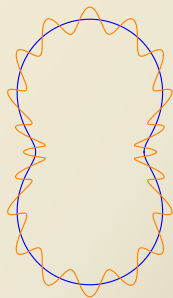
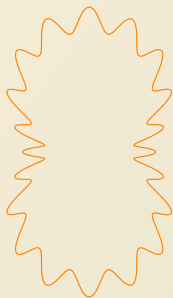
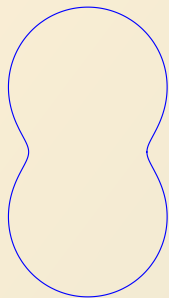
不能. 要看脸. 后面会举一个失败的例子.

■ 如果 V_n 如果逐点收敛于 V , ∇V_n 会收敛于 ∇V 吗?

不能. 需要 V_n 一致收敛和 ∇V_n 一致收敛.

但是, 对于比较简单的形状, 如果 V_n 会收敛...
那么通常 V_n 收敛很快, 而且 ∇V 也会收敛很快.
 \Rightarrow *It works.*

虽然不太可能发生, 可谁知道会不会呢...



■ V_n 可能一致收敛于 V , 但是...

V_n 的等势面有凹陷, 凹陷处的电荷密度是很低的——而 V 的等势面没有这种凹陷.

⇒ 通过 ∇V_n 得出的 σ 不可能收敛于正确值.

∇V 不收敛也没那么糟

- 导体表面的电荷分布会使静电能最小, 即

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \iiint E^2 dV$$

会取得最小值.

- 即使 V_n 的导等势面出了一点差错, 只要 V_n 的振荡不太剧烈, 导体表面的电场就是一致有界的——表面的电场对 W 的贡献极小.

⇒ 如果我让 $\theta \sim \theta + d\theta$ 内两个等势面上的 dq 强行相等...
 W 也几乎还是最小值.

在一个小的 $\Delta\theta$ 上平均从 V_n 得到的 σ , 可以逼近正确值.

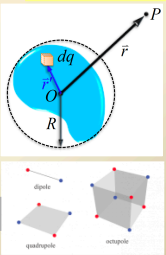
滤波器？多极展开

$$V = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A_k P_k(\cos \theta)}{r^{k+1}} \quad \text{中的 } A_k \text{ 是有物理意义的...}$$

任意带电体的电场

■ 对于任一局域电荷分布，其电场可以写为 $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots$

总电场	
点电荷 电场	总的电量: $Q = \int dq, \sum_i q_i$
+	
电偶极子 电场	电偶极矩: $\vec{p} = \int \vec{r} dq, \sum_i q_i \vec{r}_i$
+	
电四极子 电场	电四极矩: $\vec{D} = \int (3\vec{r}\vec{r} - r^2\vec{I}) dq$
+ ... + ...	



2019年3月12日
电磁学A, 2018年春
26

如果导体是由 $r = r(\theta)$ 旋转而成, 而旋转出来的导体在 $\theta \sim \theta + d\theta$ 这个范围内的电荷量为 $\lambda(\theta) d\theta$, 则

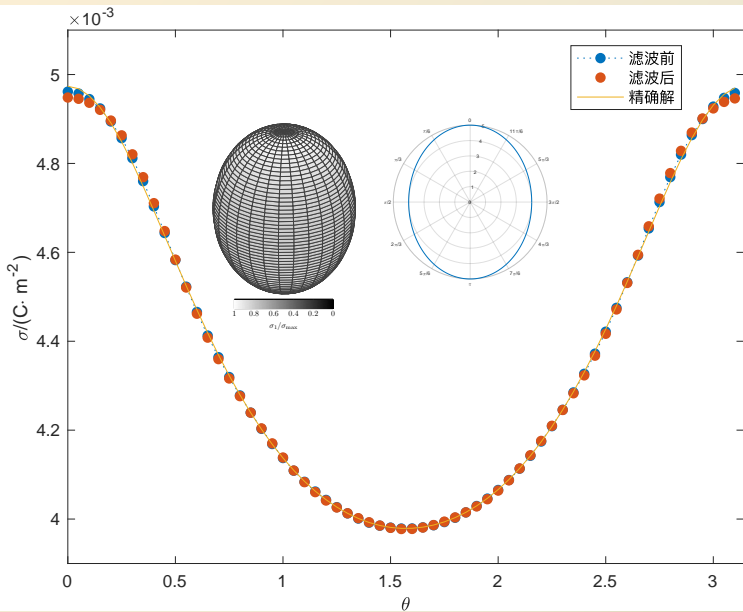
$$A_k = \int_{-\pi}^{\pi} r(\theta)^k \lambda(\theta) P_k(\cos \theta) d\theta.$$

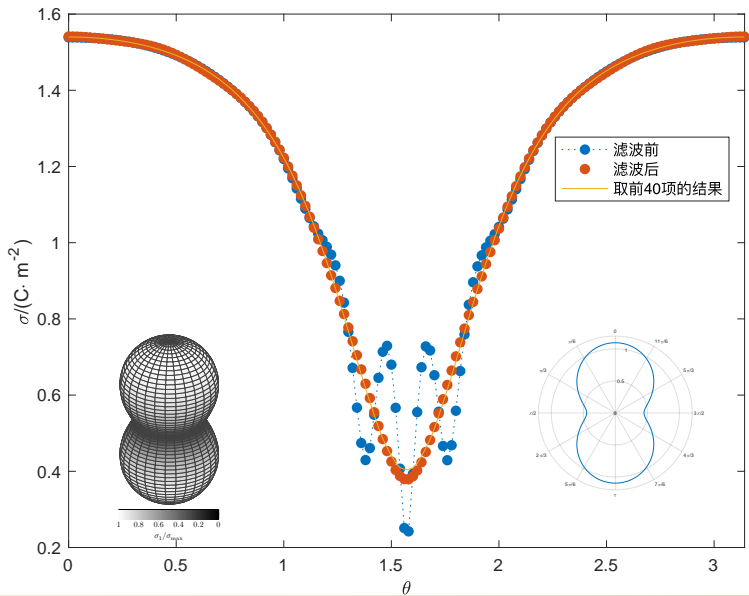
如果 $\lambda(\theta)$ 可以展开并截断为

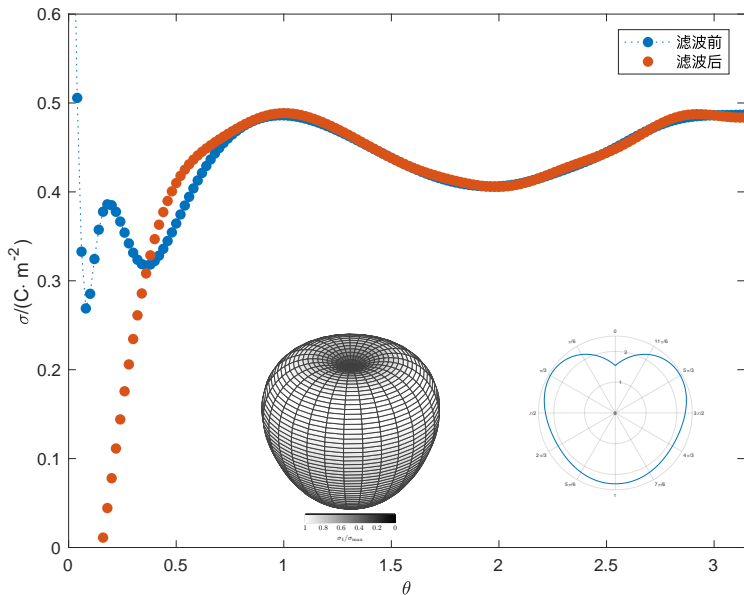
$$\lambda(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \Lambda_l P_l(\cos \theta) \sim \sum_{l=0}^n \Lambda_l P_l(\cos \theta).$$

就可以从 A_k 反解出 Λ_l —— $n+1$ 个未知数, $n+1$ 个方程.

就可以反解出 λ , 顺带可以消去振荡.





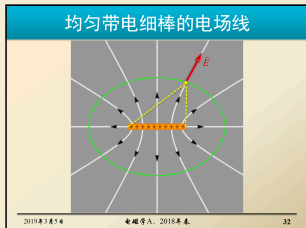


为什么会发散？

导体外部的电势的展开

$$V = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A_k P_k(\cos \theta)}{r^{k+1}}$$

其实不一定要收敛...



对于一个旋转对称的椭球形导体面，

$$A_k = O(c^k).$$

但 $P_k(x)$ 在 -1 到 1 之间振荡...
 $r < c$ 处不可能收敛.

■ A_n 的下降率, 与这个导体的像电荷产生的多极矩相同.
如果导体的像电荷半径至少为 c , 则在 $r < c$ 处不收敛.

■ 其实还有一类必定会发散的情形...

如果导体表面有退化的点 (不可微/退化为线/面), 则不会得到正确的 σ .

■ 导体表面过于不平整, 也会导致不收敛.

$$2\kappa_M = \frac{d \log E}{dn},$$

因此, 对于一个电荷分布, 越靠外的等势面大体上 κ_M 越小.
如果导体表面有比较 κ_M 比较大的点...

$V = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A_k P_k(\cos \theta)}{r^{k+1}}$ 的等势面会在导体内部一相当接近导体的 $r = c$ 处产生退化...

$\Rightarrow V$ 在 $r < c$ 处必定发散.

更多应用

- 可以用来求具有旋转对称性的电容器的电容.

仅仅局限于一极板包含在另一极板内的情形.

- 将同样的方法应用到平面上的 Laplace 方程的解

$$V = C \ln r + \sum_{k=-\infty}^{\infty} r^n (A_n \sin n\theta + B_n \cos n\theta)$$

可以求解具有平移对称性的导体外的电势和表面电荷.

- 还可以求解具有平移对称性的二导体之间的电容...

无需求一极板在另一极板内——可以通过保形映射转化一极在另一极外的情形.

谢谢